

性能特点：

- RF/LO 频段：6GHz-26GHz
- IF 频段：DC-10GHz
- 变频损耗：8dB
- RF-IF 隔离度：12dB
- LO-IF 隔离度：25dB
- LO-RF 隔离度：35dB
- 本振功率：13dBm
- 芯片尺寸：1.38mm×0.9mm×0.1mm

产品简介：

HH-MX773 是一种 GaAs MMIC 无源双平衡混频器，射频/本振频率分别覆盖 6-26GHz，中频频率覆盖 DC-10GHz，变频损耗小于 10dB，射频到中频隔离度大于 7dB，本振到中频隔离度大于 20dB，本振到射频隔离度大于 29dB，典型本振输入功率为 13dBm。

电参数： (TA=25°C, IF=0.5GHz, LO=13dBm)

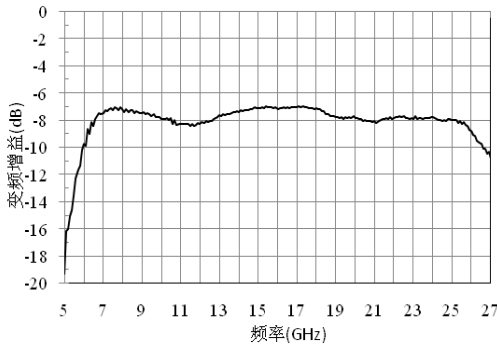
| 指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|-------|-----|------|-----|
| 射频频率 | 6-26 | | | GHz |
| 本振频率 | 6-26 | | | GHz |
| 中频频率 | DC-10 | | | GHz |
| 变频损耗 | 7 | 8 | 10 | dB |
| RF-IF 隔离度 | 7 | 12 | 23 | dB |
| LO-IF 隔离度 | 20 | 25 | 33 | dB |
| LO-RF 隔离度 | 29 | 35 | 55 | dB |
| P1dB(input) | 9.5 | 12 | 13.5 | dBm |

使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

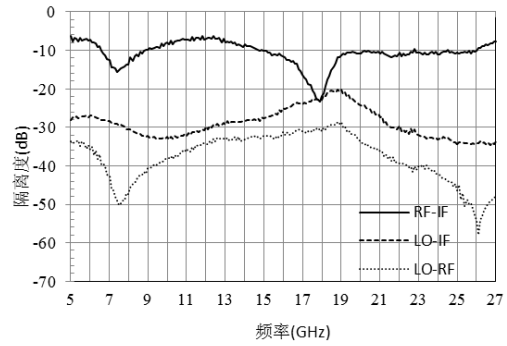
| | |
|---------|-------------|
| 射频/中频功率 | 21dBm |
| 本振功率 | 21dBm |
| 存储温度 | -65°C-150°C |
| 使用温度 | -55°C-125°C |

典型曲线：

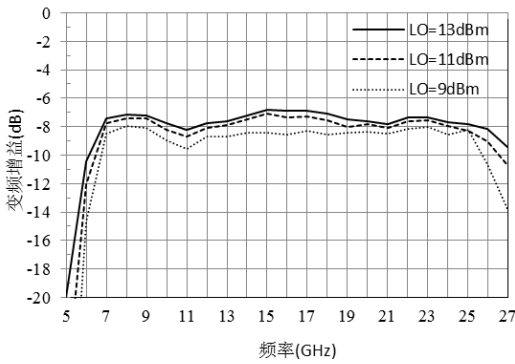
变频损耗曲线@LO=13dBm, 中频频率 0.5GHz



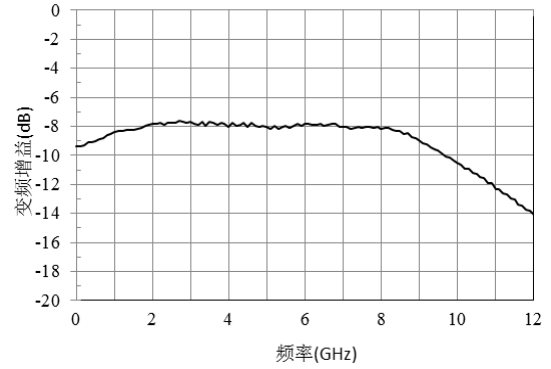
隔离度@LO=13dBm,中频频率 0.5GHz



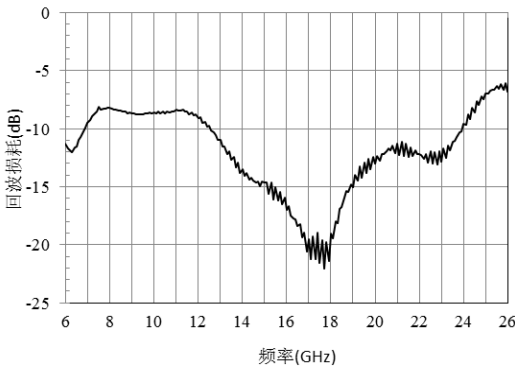
变频损耗曲线@中频频率 0.5GHz



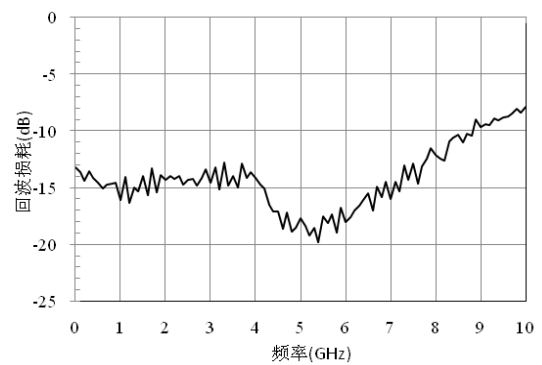
中频带宽@LO=26GHz,LO=13dBm



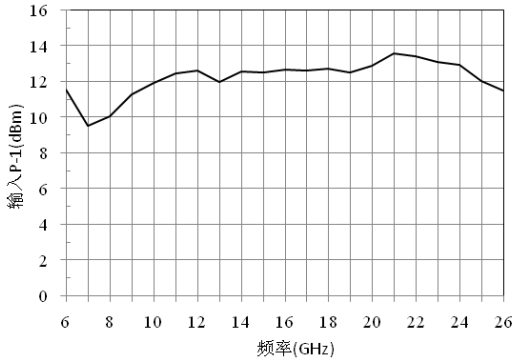
射频回波损耗



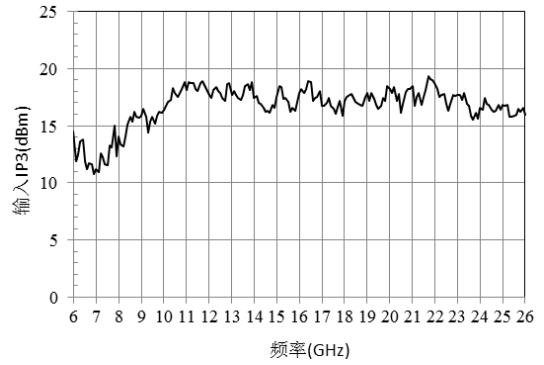
中频回波损耗



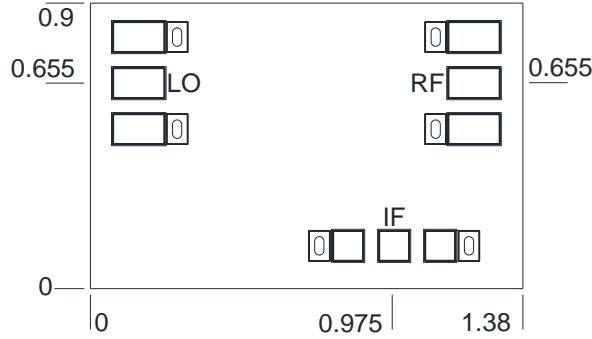
输入 P-1@LO=13dBm



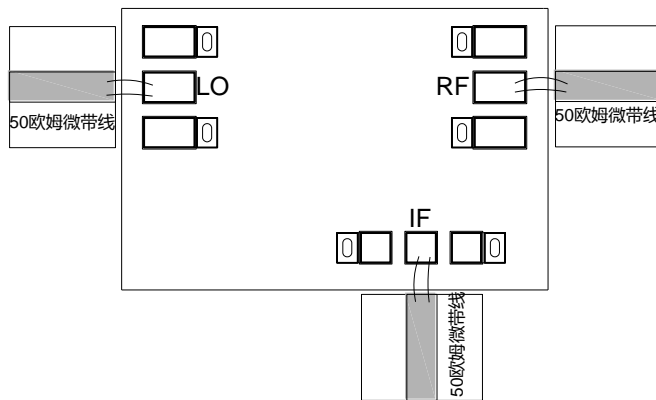
输入 IP3@LO=13dBm



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。